

2SB966/2SD1289

PNPエピタキシャル/NPN三重拡散形シリコントランジスタ

低周波電力増幅用

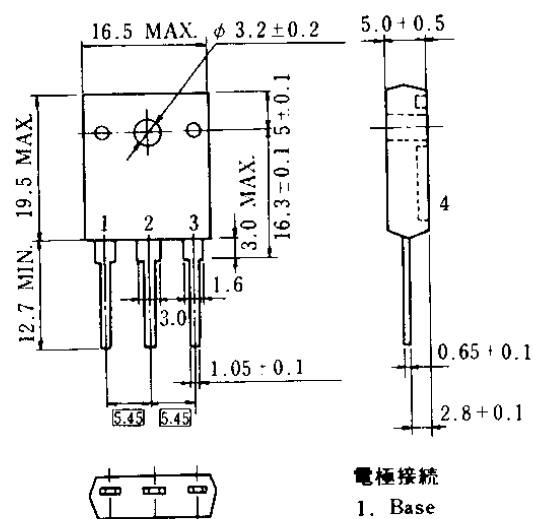
PNP Silicon Epitaxial/NPN Silicon Triple Diffused Transistor
Audio Frequency Amplifier

○実効出力45~55 W (Singl-PP, $R_L=8\ \Omega$)のパワーアンプ出力用。

○New EBT構造を採用, f_T が高く, 破壊強度が優れています。

○直流電流増幅率 h_{FE} の電流特性が優れています。

外形図/PACKAGE DIMENSIONS
(Unit: mm)



電極接続
1. Base
2. Collector
3. Emitter
4. Fin (Collector)

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25\ ^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	2SB966	2SD1289	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-120	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-120	120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5.0	5.0	V
コレクタ電流	$I_{C(DC)}$	-8.0	8.0	A
コレクタ電流	$I_{C(pulse)} *$	-12	12	A
全 損 失	$P_T(T_c=25\ ^\circ\text{C})$	80		W
ジャンクション温度	T_j	150		$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150		$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10\ \text{ms}$, Duty Cycle $\leq 50\ \%$

電氣的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25\ ^\circ\text{C}$)

2SB966/2SD1289

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -120/120\ \text{V}, I_E = 0$			-50/50	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0/5.0\ \text{V}, I_C = 0$			-50/50	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -5.0/5.0\ \text{V}, I_C = -50/50\ \text{mA} *$	40	150/120		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -5.0/5.0\ \text{V}, I_C = -1.0/1.0\ \text{A} *$	60	140	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5.0/5.0\ \text{A}, I_B = -0.5/0.5\ \text{A} *$		-0.65/0.65	-1.5/1.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -5.0/5.0\ \text{A}, I_B = -0.5/0.5\ \text{A} *$		-1.25/1.25	-2.0/2.0	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10/10\ \text{V}, I_E = 0, f = 1.0\ \text{MHz}$		200/120		pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -5.0/5.0\ \text{V}, I_C = -1.0/1.0\ \text{A}$		65/60		MHz

* パルス測定 $PW \leq 350\ \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\ \%$

h_{FE2} 区分/R: 60~120 Q: 100~200 P: 160~320